GC 115*

Verwendung: Germanium-pnp-Niederfrequenz-Transistor für Vor- und Treiberstufen bei Umgebungstemperaturen θa von –25°C bis +65°C

Standard: TGL 200-8392

Abmessungen: Bauform A 3/25b,

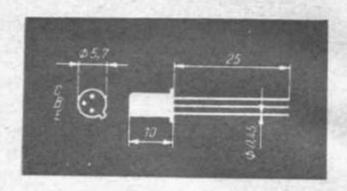
TGL 11 811 Masse ≈ 0,8 g

Zubehörteile siehe Seite 10

Zulässige Höchstwerte

bei RBE =
$$1 k\Omega$$
 freitragend

Kennwerte für ∂a = 25 °C -5 grd



Wärmewiderstand

$$R_{th} \leq 430 \frac{grd}{W}$$
 $R_{thi} \leq 165 \frac{grd}{W}$

	Min	Тур	Max	Meßbedingungen		
Restström	e					
-ICBO -ICEO -ICER -IEBO		1,5 μA 80 μA 10 μA	15 μA 600 μA 250 μA 100 μA	-UCB = 6 V -UCE = 6 V -UCE = 20 V, RBE = 1 kΩ -UEB = 10 V		

Ubergangsfrequenz

IT	500 kHz		E IF I	2 mA,	
Rausch	nmaß				
F	NEW YORK OF THE PARTY OF THE PA	9 dB	20 dB	-lice = 1 V	

-lc ⊿f

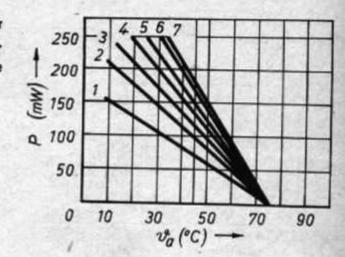
Vierpolwerte in Emitterschaltung

htte		0,5 kΩ	1,3 kΩ	-UCE	-	6 V, 2 mA 1 kHz	
h12e h22e h21e	11	2 · 10-4 60 μS	20 · 10-4 150 μS 22			1 NTZ	

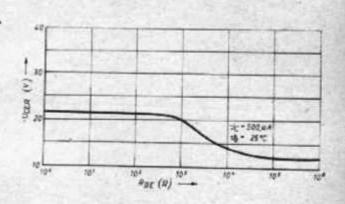
Bestellbeispiel für einen Transistor mit Kühlkörper Transistor GC 115 - TGL 200-8392 Bestell-Nr. 5801.031-02010

= 0,3 mA, f = 1 kHz, = 1 kHz, Rg = 500 Ω Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur da bei verschiedenen Al-Kühlblechgrößen von 2 mm Stärke (vertikale Montage, Blech ungeschwärzt)

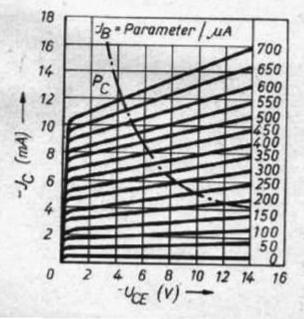
- 1 freitragend 2 mit Kühlschelle
- 3, 4, 5 und 6 Kühlfläche 7 ideale Wärmeableitung

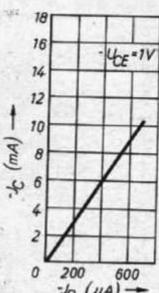


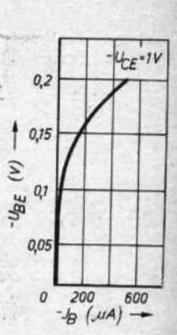
Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängigkeit vom Basisabschlußwiderstand

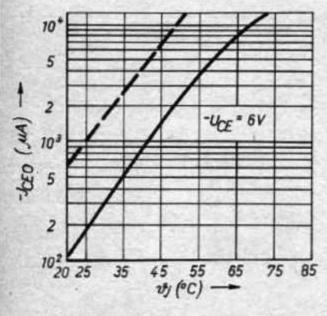


Mittlere Kennlinien für $\theta_a = 25$ °C





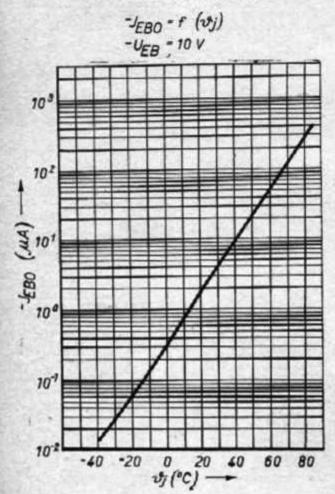




Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

---- Grenzwert Mittelwert

Emitter-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur



Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

